

付

## 特許・実用新案登録一覽

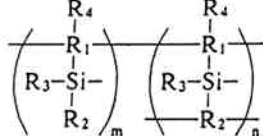
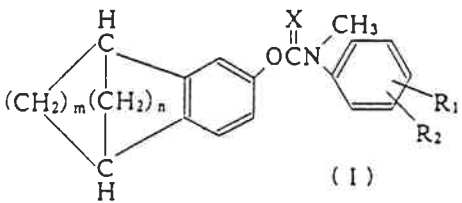
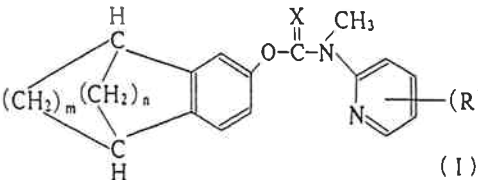
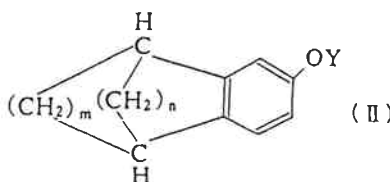
—昭和63年度—

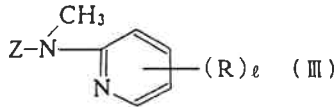
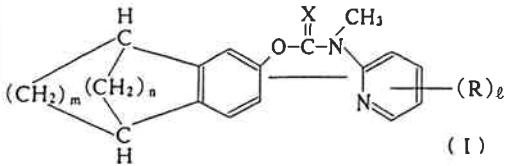
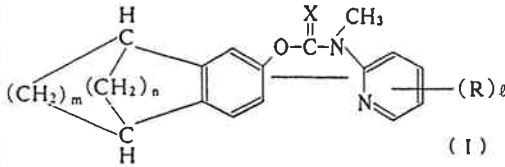
〈日本特許〉 79件

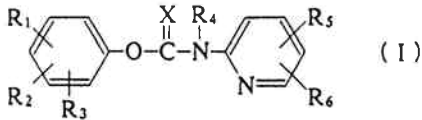
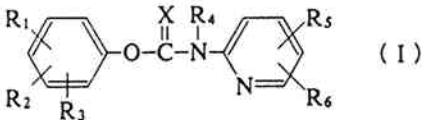
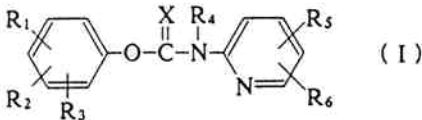
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
1	56-173810 (56.10.30) (藤本輝雄)	62-27848 (62.6.17) (藤本輝雄)	1419803 (63.1.14)	両性イオン交換体及びその製造法	<p>1 陽イオン交換基をもつ高分子鎖 <math>A^-</math> と陰イオン交換基をもつ高分子鎖 <math>B^+</math> とイオン交換基をもたない高分子鎖 <math>C</math> とからなる三元ブロックポリマーにおいて、該高分子鎖 <math>A^-</math> と高分子鎖 <math>B^+</math> とが互に隣り合わないよう直鎖状に連結され、かつ上記の陽イオン交換基をもつ高分子鎖 <math>A^-</math> および陰イオン交換基をもつ高分子鎖 <math>B^+</math> はイオン交換基を含まない原ポリマー換算で夫々全体の5%以上を占め又上記のイオン交換基をもたない高分子鎖 <math>C</math> はイオン交換基を含まない原ポリマー換算で全体の30~90%を占めていることを特徴とする両性イオン交換体。</p> <p>2 重合によって陽イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック <math>A</math> を生成しうるモノマーと、同じく重合によって陰イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック <math>B</math> を生成しうるモノマーと、同じく重合によってイオン交換基をもたない高分子ブロック <math>C</math> を生成しうるモノマーとをリビングアニオン重合法によって陽イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック <math>A</math> と陰イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック <math>B</math> とがイオン交換基をもたない高分子ブロック <math>C</math> によって互に隔離されるように順次直鎖状にブロック共重合せしめて陽イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック <math>A</math> 及び陰イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック <math>B</math> を夫々重量比で生成ブロック共重合体全体に対し5%以上含有し、かつイオン交換基をもたない高分子ブロック <math>C</math> の重量比が生成マルチブロック共重合体全体に対し30~90%である原マルチブロック共重合体を作り、得られる原マルチブロック共重合体に対し高分子ブロック <math>A</math> に陽イオン交換基を導入してこれを陽イオン交換基をもつ高分子鎖 <math>A^-</math> とする工程、高分子ブロック <math>B</math> に陰イオン交換基を導入してこれを陰イオン交換基をもつ高分子鎖 <math>B^+</math> とする工程及び高分子ブロック <math>C</math> を架橋してイオン交換基をもたない高分子鎖 <math>C</math> とする工程を行うことを特徴とする陽イオン交換基をもつ高分子鎖 <math>A^-</math> と陰イオン交換基をもつ高分子鎖 <math>B^+</math> とが互に隣り合わないようイオン交換基をもたない高分子鎖 <math>C</math> によって隔離された両性イオン交換体を製造する方法。</p>
2	53-141174 (53.11.17) (蔵本村山)	61-46501 (61.10.14) (憲一, 上野 浩)	1421666 (63.1.29) (喜美)	被覆有機顔料	<p>1 フタロシアニン、アンスラキノン、ペリレン又はアゾ系顔料の粒子核上に複数個の界面活性剤分子の親水基又は疎水基を吸着させ、界面活性剤層を形成し、該核上の界面活性剤空隙部分に不溶性金属塩を充填し、充填層を形成し、かつ界面活性剤の親水基に二価以上の金属イオンを結合してなる被覆有機顔料。</p>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
3	57-127280 (57. 11. 27) (近藤 溝口)	62-34689 (62. 7. 28) (徳矩, 小林 順造)	1423972 (63. 2. 15) (洋治)	半水石こうの水和方法	1 ストロンチウムを含む半水石こうを水和して二水石こうを得るにあたり、該半水石こうをSO <sub>4</sub> 濃度≧5 wt%, O≦P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /SO <sub>4</sub> (重量比)<1 の組成を有する硫酸又は硫酸とリン酸の混酸と接触させたのち水と接触させて水和させることを特徴とする半水石こうの水和方法。
4	54-79123 (54. 6. 25) (河村 浅野)	62-29092 (62. 6. 24) (秀雄, 宮之原 精一)	1424475 (63. 2. 15) (勲)	硫黄系悪臭物質の除去剤の製造方法	1 鉄およびマンガン塩の酸性混合水溶液を20分以内で pH 8 以上に調整して、鉄およびマンガンの酸化物を析出させた後、該成分を主成分としてバインダーの不存在下、造粒・成型することを特徴とする硫黄系悪臭物質の除去剤の製造方法。
5	50-157879 (50. 12. 27) (加藤 清田)	62-30995 (62. 7. 6) (芳男, 橋本 徹, 清水 明彦)	1427049 (63. 2. 25)	核酸塩基、ヌクレオシド及びヌクレオチドの分離方法	1 核酸塩基、ヌクレオシド及びヌクレオチドをクロマトグラフィーで分離する方法において、担体としてエポキシ基を含む多孔性ゲルに核酸塩基を結合せしめた担体を使用することを特徴とする核酸塩基、ヌクレオシド及びヌクレオチドの分離方法。
6	53-131593 (53. 10. 27) (宮之原 水井 規雅, 前田 一)	62-35968 (62. 8. 5) (勲, 諸藤 正光)	1427093 (63. 2. 25)	重炭酸ナトリウムの製造法	1 反応器内の液体の温度及び組成が均一となるようにほぼ完全混合状態にある完全混合型の反応装置に、下記の(1)式と(3)式又は(2)式と(3)式で表わされる範囲内の濃度を有する炭酸ナトリウム又は水酸化ナトリウムの水溶液と、二酸化炭素又は二酸化炭素含有ガスを連続的に供給して、常に器内の液組成を重曹析出領域に維持しつつ、40~100°C の温度において反応を行い、重炭酸ナトリウムを析出させる事の特徴とする重炭酸ナトリウムの製造法。 $-0.727x+22 \leq y \leq -1.03x+32.5 \quad (1)$ $-0.60x+18.2 \leq z \leq -0.88x+25 \quad (2)$ $0 \leq x \leq 20 \quad (3)$ (ただし、上式中 y は炭酸ナトリウム濃度 (重量%), z は水酸化ナトリウム濃度 (重量%), x は塩化ナトリウム濃度 (重量%) を表す。)
7	53-139422 (53. 11. 14) (小宮 深野 克夫, 佐々木博朗 一幸)	62-33550 (62. 7. 21)	1427098 (63. 2. 25)	イオン交換液体クロマトグラフィー用担体およびその製法	1 シリカゲル担体細孔表面のシラノール基 Si と下記一般式 (I) Si とが Si-O-Si により結合されていることを特徴とするイオン交換液体クロマトグラフィー用担体。 一般式 (I) $\left( \begin{array}{c} R_4 \\   \\ R_1 \\   \\ R_3-Si- \\   \\ R_2 \end{array} \right)_m - \left( \begin{array}{c} R_4 \\   \\ R_1 \\   \\ R_3-Si- \\   \\ R_2 \end{array} \right)_n \quad (I)$ {R <sub>1</sub> ; C-C, C-O, C-H および O-H の結合または C-C, C-O, C-H, O-H および C-X (X; ハロゲン原子) の結合 (ハロゲン原子含有量は20重量%以下) で構成され、Si とは Si-C 結合からなり、C と O の原子比 (C/O) が2.5以下の有機基, R <sub>2</sub> ; R <sub>1</sub> と同じ有機基, メトキシ基, エトキシ基または水酸基, R <sub>3</sub> ; メチル基, エチル基, メトキシ基, エトキシ基または水酸基, R <sub>4</sub> ; A-B-C で示される分子量400以下の

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					<p>有機基 (A:イオン交換基で第1級アミノ基, 第2級アミノ基, 第3級アミノ基, 第4級アンモニウム塩基, グアニド基, これらを含むポリアミノ基, カルボキシル基, スルホン酸基またはリン酸基, B:炭素数1ないし4の脂肪族基または炭素数3ないし18のエチレンオキサイドもしくはプロピレンオキサイドのオリゴマーまたはポリオール骨格を有するポリエーテル基, C:エーテル結合, 第2級アミノ基, 第3級アミノ基, エステル結合, C-C結合により R<sub>1</sub>と結合している)</p> <p>m; 1以上の整数, n; 0または1以上の整数}</p> <p>2 シリカゲル担体細孔表面のシラノール基と一般式 (II)</p> $  \begin{array}{c}  R_5 \quad R_7 \\  \diagdown \quad / \\  Si \\  / \quad \diagdown \\  R_6 \quad R_8  \end{array}  \quad (II)  $ <p>{R<sub>5</sub>; エポキシ基を有し構成原子の原子量の総和が57~147の有機基, R<sub>6</sub>; R<sub>5</sub>と同じ有機基, メトキシ基, エトキシ基またはハロゲン原子, R<sub>7</sub>, R<sub>8</sub>; メチル基, エチル基, メトキシ基, エトキシ基またはハロゲン原子}</p> <p>で表されるオルガノシランを担体およびオルガノシランに不活性な溶媒の存在下あるいは非存在下, 20°C ないし 300°C で反応させ Si-O-Si 結合を形成し, 次いで C-C, C-O, C-H および O-H の結合または C-C, C-O, C-H, O-H および C-X (X; ハロゲン原子) の結合 (ハロゲン原子含有量は20重量%以下) で構成され, CとOの原子比 (C/O) が2.5以下, 分子量1000以下かつエポキシ当量 (分子量/エポキシ基の数) 350以下のエポキシ基含有有機物および</p> <p>一般式 A-B-D</p> <p>{A:イオン交換基で第1級アミノ基, 第2級アミノ基, 第3級アミノ基, 第4級アンモニウム塩基, グアニド基, これらを含むポリアミノ基, カルボキシル基, スルホン酸基またはリン酸基, B; 炭素数1ないし4の脂肪族基または炭素数3ないし18のエチレンオキサイドもしくはプロピレンオキサイドのオリゴマーまたはポリオール骨格を有するポリエーテル基, D; 水酸基, エポキシ基, 第1級アミノ基, 第2級アミノ基, カルボン酸基, ハロゲン原子または水素原子}</p> <p>で示され, かつ分子量400以下のイオン交換基を有する有機物をオルガノシラン処理担体と, これらに不活性な溶媒中で, 触媒の存在下あるいは非存在下, -20°C ないし 200°C で共重合または付加反応させることを特徴とするシリカゲル担体細孔表面のシラノール基 Si と下記一般式 (I) Si とが Si-O-Si により結合されているイオン交換液体クロマトグラフィー用担体の製法。</p>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
					 <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>{R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub>, m, n; 前記に同じ}</p>
8	54-63236 (54. 5. 24) (武本	62-36056 (62. 8. 5) 勝雄, 村山	1427124 (63. 2. 25) 浩)	ポリオレフィン成形物の表面改質法	<p>1 塩化ビニリデン単量体単独雰囲気下又は塩化ビニリデンおよびこれと共重合可能な単量体との混合雰囲気下でポリオレフィン系重合体成形物に光を照射して前記単量体を前記重合体成形物にグラフト重合することを特徴とするポリオレフィン系重合体成形物の表面改質法。</p>
9	57-106737 (57. 6. 23) (竹松	62-34002 (62. 7. 24) 哲夫, 近内	1427322 (63. 2. 25) 誠登	カーバメート誘導体を含有する除草剤	<p>1 一般式 (I) :</p>  <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>(式中, mは1または2を, nは0, 1または2を示す。ただしnが0のとき-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-が結合している二個の炭素には-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-に代りそれぞれ水素原子が結合するものとする。Xは酸素原子または硫黄原子を, R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> は各々水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基またはトリフルオルメチル基を示し, 互に同一または相異なる。) で表わされるカーバメート誘導体を有効成分として含有することを特徴とする除草剤。</p>
10	57-129651 (57. 7. 27) (竹松	62-37035 (62. 8. 10) 哲夫, 近内	1427330 (63. 2. 25) 誠登	カーバメート誘導体	<p>1 一般式 (I) :</p>  <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>(式中, mは1又は2を示し, nは0, 1又は2を示し, Xは酸素原子又は硫黄原子を示し, Rは水素原子, ハロゲン原子又は低級アルキル基を示し, lは1又は2を示す。ただしnが0の場合, -(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-が結合している2個の炭素には-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-に代り, それぞれ水素原子が結合するものとする。) で表わされるカーバメート誘導体。</p> <p>2 一般式 (II)</p>  <p style="text-align: right;">(II)</p>

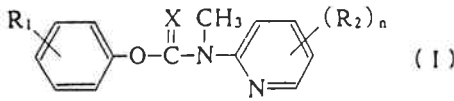

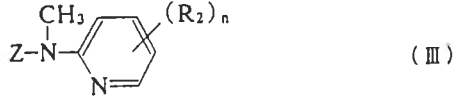
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					<p>(式中、Yは水素原子、ハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基であり、mは1又は2、nは0、1又は2を示す。ただし、nが0の場合は <math>-(CH_2)_n-</math> が結合している二個の炭素には <math>-(CH_2)_n-</math> に代り、それぞれ水素原子が結合するものとする。) で表わされるフェノール誘導体を</p> <p>一般式 (III)</p>  <p>(式中、Zは(II)式のYが水素原子のときハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基であり(II)式のYがハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基のとき水素原子である。Rは水素原子、ハロゲン原子又は低級アルキル基を示し、ℓは1又は2を示す。) で表わされるアミノピリジン誘導体と反応させることを特徴とする</p> <p>一般式 (I)</p>  <p>(式中、mは1又は2、nは0、1又は2を示し、Xは酸素原子又は硫黄原子を示し、Rは水素原子、ハロゲン原子又は低級アルキル基を示し、ℓは1又は2を示す。ただしnが0の場合、<math>-(CH_2)_n-</math> が結合している2個の炭素には <math>-(CH_2)_n-</math> に代り、それぞれ水素原子が結合するものとする。) で表わされるカーバメート誘導体の製造法。</p> <p>3 一般式 (I)</p>  <p>(式中、mは1又は2を示し、nは0、1又は2を示し、Xは酸素原子又は硫黄原子を示し、Rは水素原子、ハロゲン原子又は低級アルキル基を示し、ℓは1又は2を示す。ただしnが0の場合、<math>-(CH_2)_n-</math> が結合している2個の炭素には <math>-(CH_2)_n-</math> に代り、それぞれ水素原子が結合するものとする。) で表わされるカーバメート誘導体を有効成分として含有することを特徴とする除草剤。</p>

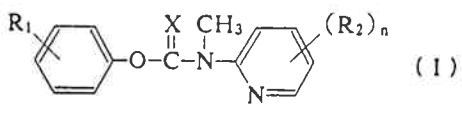
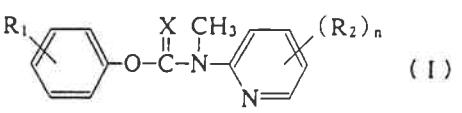
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
11	58-34651 (58. 3. 4) (竹松 森中 中西 橋濱)	62-34756 (62. 7. 28) 哲夫, 近内 秀夫, 野中 明, 続木 充幸, 魚谷	1427351 (63. 2. 25) 誠登 悠次 建治 武)	カーバメート誘導体	<p>1 一般式 (I) :</p>  <p>(式中, R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> はハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基, 低級アルケニルオキシ基, 低級アルキニルオキシ基, 低級アルキルチオ基, ニトロ基またはアシル基を示し, R<sub>3</sub> は水素原子または低級アルキル基を示し, R<sub>4</sub> は低級アルキル基を示し, R<sub>5</sub> は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基または低級アルキルアミノ基を示し, R<sub>6</sub> は水素原子または低級アルキル基を示し, Xは酸素原子または硫黄原子を示す。)</p> <p>で表わされるカーバメート誘導体。</p> <p>2 一般式 (II) :</p> <p>低級アルキル基を示し, R<sub>5</sub> は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基または低級アルキルアミノ基を示し, R<sub>6</sub> は水素原子または低級アルキル基を示す。)</p> <p>で表わされるアミノピリジン誘導体と反応させることを特徴とする</p> <p>一般式 (I) :</p>  <p>(式中, R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> はハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基, 低級アルケニルオキシ基, 低級アルキニルオキシ基, 低級アルキルチオ基, ニトロ基またはアシル基を示し, R<sub>3</sub> は水素原子または低級アルキル基を示し, R<sub>4</sub> は低級アルキル基を示し, R<sub>5</sub> は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基または低級アルキルアミノ基を示し, R<sub>6</sub> は水素原子または低級アルキル基を示し, Xは酸素原子または硫黄原子を示す。)</p> <p>で表わされるカーバメート誘導体の製造法。</p> <p>3 一般式 (I) :</p>  <p>(式中, R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> はハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基, 低級アルケニルオキシ基, 低級アルキニルオキシ基, 低級アルキルチオ基, ニトロ基またはアシル基を示し, R<sub>3</sub> は水素原子または低級アルキル基を示し, R<sub>4</sub> は低級アルキル基を示し, R<sub>5</sub> は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基または低級アルキルアミノ基を示し, R<sub>6</sub> は水素原子または低級アルキル基を示し, Xは酸素原子または硫黄原子を示す。)</p>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
					<p>Xは酸素原子または硫黄原子を示す。) で表わされるカーバメート誘導体を有効成分として含有することを特徴とする除草剤。</p>
12	61-177598 (61. 7. 30)	62-32183 (62. 7. 13)	1427367 (63. 2. 25)	ジエン系含フッ素化合物の製法	<p>1 1, 2-ジクロロ-1, 2-ジフルオロエチレンと炭素数 1~3 の飽和アルコールのテロメル化反応によって得られる 一般式 <math display="block">H(C_2F_2Cl_2)_2-Y-OH</math> (Yは炭素数 1~3 の炭化水素基) で表わされる化合物を酸化剤で酸化したのち脱塩化水素反応, 次いでエステル化反応を行い, あるいはエステル化反応次いで脱塩化水素反応を行い, 更に脱塩素反応を行うことを特徴とする 一般式 <math display="block">ClFC=CF-CF=CF-(G)_x-C \begin{matrix} O \\ // \\ Z \end{matrix}</math> (Gは炭素数 1 又は 2 の炭化水素基。xは 0 または 1。Zはアルコキシ基。) で示されるジエン系含フッ素化合物の製法。</p>
13	54-16091 (54. 2. 16)	62-31294 (62. 7. 7)	1433870 (63. 4. 7)	レーザ光散乱光度計	<p>1 被検出液体の散乱光強度を測定するレーザ光散乱光度計において測定セルと光トラップを中心に装着した円環スリットとをそれらの中心軸がいずれもレーザ入射光束の光軸に一致するように配し, かつ, 前記光トラップで反射された透過光成分を検出する透過光強度検出部および前記円環スリットにより限定された散乱光成分を検出する散乱光強度検出部とを設け, 更に, 前記透過光強度検出部によって検出される透過光強度の変動を検出すると共に, その変動に対応した出力信号を前記散乱光強度検出部に入力する変動解消回路を形成し, この出力信号によって, 入射光強度の変動によって生じる散乱光強度検出部の出力の変動を相殺するように構成したことを特徴とするレーザ光散乱光度計。</p>
14	57-159578 (57. 9. 16)	62-41616 (62. 9. 3)	1433960 (63. 4. 7)	艶消成型品	<p>1 (a)塩化ビニル系樹脂100重量部, (b)エチレン-酢酸ビニル共重合体の存在下, 重合温度における塩化ビニルモノマーの飽和蒸気圧未満の圧力でかつ, モノマー油滴が実質的に存在しないモノマー濃度の極めて低い状態でグラフト重合されたエチレン-酢酸ビニル共重合体-塩化ビニルグラフト共重合体 1~100重量部および (c)可塑剤30~200重量部とからなる艶消成型品。</p>
15	54-22561 (54. 3. 1)	62-45167 (62. 9. 25)	1436738 (63. 4. 25)	安定化したA型ゼオライト	<p>1 一般式 <math display="block">(aNa_2O + (1-a)MO) \cdot Al_2O_3 \cdot xSiO_2 \cdot yH_2O</math> (aは0.667~0.917, xは2±0.2, yは6以下であり, Mは周期律表の第II族, 第IV族元素, 遷移金属元素の内のいずれかで2価陽イオンを表わす) で表わされ, かつ活性化状態で, 25°C, 40 mmHg の n-ペンタン圧力下に於いて16時間後の n-ペンタン吸着量が1重量%以下である安定化したA型ゼオライト。</p>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
16	56-183038 (56. 11. 17) (上田 智, 福島 利久 小泉 光恵)	62-43927 (62. 9. 17)	1436792 (63. 4. 25)	結晶性モルデナイトの製造法	<p>1 反応組成物が酸化物のモル比で表わして次の組成</p> $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3=109\sim 240$ $\text{Na}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3=28.6\sim 67$ $\text{Q}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3=0.18\sim 2.96$ $\text{H}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3=1029\sim 2930$ <p>(ここでQはベンジルトリメチルアンモニウムイオンを表わす)</p> <p>の反応組成物を自生圧力下において70~140°Cの温度で反応させることを特徴とするハイシリカ結晶性モルデナイトの製造法。</p>
17	54-30559 (54. 3. 17) (山田 邦貴, 鈴木 祐二)	62-48681 (62. 10. 15)	1441909 (63. 5. 30)	ポリオレフィンの製造方法	<p>1 (i) マグネシウムジハロゲン化物を、一般式 <math>\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{O}-\text{R}</math> (Rは炭素数1~10のアルキル基またはエーテル基やグリシジル基を含んでいるものでもよい) および/または一般式 <math>\text{CH}_2=\text{CH}-\text{O}-\text{R}'</math> (R'は炭素数1~10のアルキル基, またはエーテル基, グリシジル基, ハロゲンを含んでいるものでもよい。) で示される不飽和基をもつエーテル化合物 (<math>\alpha</math>位や <math>\beta</math>位の水素がアルキル基に置換されているものでもよい) および一般式 <math>\text{SiX}_n(\text{OR}'')_{4-n}</math> (Xはハロゲン, R''はアルキル基, nは0~4の整数) で示されるケイ素化合物と機械的に接触反応させたのちチタンテトラハライドの一般式 <math>\text{R}^1-\text{O}-\text{R}^{\text{II}}</math> (R<sup>I</sup>は炭素数2~10のアルキル, R<sup>II</sup>はR<sup>I</sup>と同じまたは異なる炭素数2~10のアルキル) および/または一般式 <math>\text{R}^{\text{I}'}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{R}^{\text{II}'}</math> (R<sup>I'</sup>は炭素数1~10のアルキル, R<sup>II'</sup>はR<sup>I'</sup>と同じまたは異なる炭素数1~10のアルキル, 水素またはエーテル結合をもった化合物) であらわされるエーテル化合物の混合物で処理することによって得た微粒状固体,</p> <p>(ii) 有機アルミニウム化合物,</p> <p>上記(i), (ii)から成る重合触媒を用いることを特徴とするポリオレフィンの製造方法。</p>
18	54-154426 (54. 11. 30) (久保 雅滋, 小山 清孝 野中 悠次)	62-48665 (62. 10. 15)	1442330 (63. 6. 8)	$\alpha$ -クロロヒドロシナムニトリルの製造法	<p>1 ベンゼンと2,3-ジクロロプロピオニトリルとを、触媒成分として五塩化アンチモン、五塩化モリブデン、塩化第二鉄またはこれらの混合物を含む触媒の存在下で反応させることを特徴とする <math>\alpha</math>-クロロヒドロシナムニトリルの製造法。</p> <p>2 ベンゼンと2,3-ジクロロプロピオニトリルとを、触媒成分として五塩化アンチモン、五塩化モリブデン、塩化第二鉄またはこれらの混合物を含む触媒及び助触媒としてのブロンステッド酸もしくはその水溶液またはシリカゲルの存在下で反応させることを特徴とする <math>\alpha</math>-クロロヒドロシナムニトリルの製造法。</p>
19	55-132796 (55. 9. 26) (藤井 修, 井上 孝彦)	62-51898 (62. 6. 8)	1442340 (63. 6. 8)	酸化鉄の製造法	<p>1 長径が <math>0.4\mu</math> 以下で、かつ幅(短径)が <math>0.04\mu</math> 以下の微細な針状の黄色酸化鉄(<math>\alpha</math>-FeOOH)を水又は10N以下のアルカリ水溶液に分散し100~250°Cで熱処理を行い、長径が <math>0.3\sim 1.0\mu</math>, 幅が <math>0.1\mu</math> 以下の単一粒子形状を有する結晶を得ることを特徴とする黄色酸化鉄の製造法。</p> <p>2 水酸化第一鉄の分散水溶液をpH11以上</p>



No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
					<p>で空気酸化して得られる長径が <math>0.4\mu</math> 以下で、かつ幅が <math>0.04\mu</math> 以下の微細な針状の黄色酸化鉄のアルカリ水溶液分散液を <math>100\sim 250^\circ\text{C}</math> で熱処理を行い、長径が <math>0.3\sim 1.0\mu</math>、幅が <math>0.1\mu</math> 以下の単一粒子形状を有する結晶を得ることを特徴とする黄色酸化鉄の製造法。</p> <p>3 長径が <math>0.4\mu</math> 以下で、かつ幅が <math>0.04\mu</math> 以下の微細な針状の黄色酸化鉄をケイ酸ソーダの存在下に水又は <math>10\text{N}</math> 以下のアルカリ水溶液に分散し <math>100\sim 250^\circ\text{C}</math> で熱処理を行い、長径が <math>0.3\sim 1.0\mu</math>、幅が <math>0.1\mu</math> 以下の単一粒子形状を有する結晶を得ることを特徴とする黄色酸化鉄の製造法。</p>
20	56-51770 (56. 4. 8)	62-51899 (62. 6. 8)	1442353 (63. 6. 8)	黄色酸化鉄の製造法	<p>1 水酸化第一鉄と硫酸第一鉄を <math>2 : 1\sim 4 : 1</math> のモル比で含み、かつ全鉄分と硫酸根 (<math>\text{SO}_4^{2-}</math>) を <math>3 : 2\sim 5 : 1</math> のモル比で含む水酸化第一鉄の懸濁水溶液に <math>60^\circ\text{C}</math> 以下の温度で、酸素含有ガスを導入する事の特徴とする黄色酸化鉄 (<math>\alpha\text{-FeOOH}</math>) の製造法。</p>
21	57-156710 (57. 9. 10)	62-54424 (62. 11. 14)	1444290 (63. 6. 8)	カーバメート誘導体	<p>1 一般式 (I) :</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">(I)</p> </div> <p>(式中、<math>\text{R}_1</math> は炭素数 <math>1\sim 5</math> のアルキル基を示し、<math>\text{R}_2</math> は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基又は低級アルコキシ基を示し、<math>n</math> は <math>1</math> 又は <math>2</math> を示し、<math>\text{X}</math> は酸素原子又は硫黄原子を示す。) で表わされるカーバメート誘導体。</p> <p>2 一般式 (II)</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">(II)</p> </div> <p>(式中、<math>\text{Y}</math> は水素原子、ハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基であり、<math>\text{R}_1</math> は炭素数 <math>1\sim 5</math> のアルキル基を示す。) で表わされるフェノール誘導体を</p> <p>一般式 (III)</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">(III)</p> </div> <p>(式中、<math>\text{Z}</math> は (II) 式の <math>\text{Y}</math> が水素原子のときハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基であり、(II) 式の <math>\text{Y}</math> がハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基のとき水素原子であり、<math>\text{R}_2</math> は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基又は低級アルコキシ基を示し、<math>n</math> は <math>1</math> または <math>2</math> を示す。) で表わされるアミノピリジン誘導体と反応させることを特徴とする。</p> <p>一般式 (I) :</p>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
					 <p>(式中、R<sub>1</sub> は炭素数1～5のアルキル基を示し、R<sub>2</sub> は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基又は低級アルコキシ基を示し、nは1又は2を示し、Xは酸素原子又は硫黄原子を示す。) で表わされるカーバメート誘導体の製造法。</p> <p>3 一般式 (I) :</p>  <p>(式中、R<sub>1</sub> は炭素数1～5のアルキル基を示し、R<sub>2</sub> は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基又は低級アルコキシ基を示し、nは1又は2を示し、Xは酸素原子又は硫黄原子を示す。) で表わされるカーバメート誘導体を有効成分として含有することを特徴とする除草剤。</p>
22	56-162697 (56. 10. 14)	62-55839 (62. 11. 21)	1446840 (63. 6. 30)	アスパルチルフエニルアラニンアルキルエステルの製造法 (原田 恒夫, 竹本 久雄, 五十嵐辰夫)	1 L-アスパラギン酸及び L-フェニルアラニン低級アルキルエステルを含む培地に、アルカリゲネス属、トルロプシス属、ロドトルラ属又はスポロボロマイセス属に属する α-L-アスパルチル-L-フェニルアラニン低級アルキルエステル生産菌を培養して α-L-アスパルチル-L-フェニルアラニン低級アルキルエステルを生成させ、これを採取することを特徴とするアスパルチルフエニルアラニンアルキルエステルの製造法。
23	58-75404 (58. 4. 28)	62-45193 (62. 9. 25)	1449193 (63. 7. 11)	ジルコニア焼結体 (高木 弘義, 藤井 幸男, 鈴木 一) (工業技術院長, 住友化学工業(株)と共願)	1 一般式 (ZrO <sub>2</sub> ) <sub>100-(x+y)</sub> (MO) <sub>x</sub> (ThO <sub>2</sub> ) <sub>y</sub> (式中 MO は Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 又はアルカリ土類の酸化物又はランタン系希土類の酸化物の一種以上から成り、xは 2 ≤ x ≤ 15, yは 0.05 ≤ y ≤ 3 の範囲である。数値はモル%を示す。) よりなるジルコニア焼結体。
24	55-74179 (55. 6. 4)	62-55540 (62. 11. 20)	1449572 (63. 7. 11)	粒状加硫促進剤の製造方法 (林 隆夫, 坂中 靖弘)	1 粉末状加硫促進剤100重量部を、2～8重量部の分子中にカルボキシル基又は水酸基を有する水溶性アニオン性高分子を含む水溶液に分散させた混合物を、アルカリ土類金属塩の少なくとも一種を含有する水溶液中に滴下造粒し、濾過、乾燥することを特徴とする粒状加硫促進剤の製造方法。
25	57-196836 (57. 11. 11)	62-56184 (62. 11. 24)	1452021 (63. 7. 25)	粗面化陽イオン交換膜を製造する方法 (大貝 理治, 清田 徹, 竹重 浩佑, 朱山 秀雄)	1 シリカ粉末と水とを混合し、懸濁あるいはペースト状の混合物となし、該混合物をオート紙あるいは濾紙上に担持せしめ乾燥することで形成したシリカ粉末層を陽イオン交換基及び/又は陽イオン交換基になりうる基を有するパーフルオロカーボン重合体膜の表面に加熱・圧着し、かかる膜表面に形成されたシリカ粉末を苛性アルカリ水溶液で溶出することにより得た粗面化陽イオン交換膜を1～10重量%苛性アルカ